



2SB1188 (3CG1188)

硅 PNP 半导体三极管/SILICON PNP TRANSISTOR

用途：用于中功率放大。

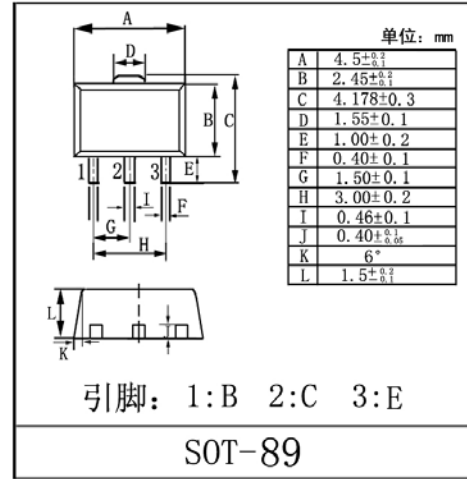
Purpose: Medium power amplifier applications.

特点：饱和压降低，与 2SD1766 (3DG1766) 互补。

Features: Low $V_{CE(sat)}$, complements the 2SD1766 (3DG1766).

极限参数/Absolute maximum ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CB0}	-40	V
V_{CE0}	-32	V
V_{EB0}	-5.0	V
I_C	-2.0	A
I_{CP}	-3.0	A
P_C	0.5	W
* P_C	2.0	W
T_j	150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}	-55~150	$^\circ\text{C}$



*:mounted on 40×40×0.7mm ceramic board.

*:装于 40×40×0.7m 的陶瓷上。

电性能参数/Electrical characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition	数值 Rating			单位 Unit
		最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
V_{CB0}	$I_C=-50\mu\text{A}$ $I_E=0$	-40			V
V_{CE0}	$I_C=-1.0\text{mA}$ $I_B=0$	-32			V
V_{EB0}	$I_E=-50\mu\text{A}$ $I_C=0$	-5.0			V
I_{CB0}	$V_{CB}=-20\text{V}$ $I_E=0$			-1.0	μA
I_{EB0}	$V_{EB}=-4.0\text{V}$ $I_C=0$			-1.0	μA
h_{FE}	$V_{CE}=-3.0\text{V}$ $I_C=-0.5\text{A}$	82		390	
$V_{CE(sat)}$	$I_C=-2.0\text{A}$ $I_B=-0.2\text{A}$		-0.5	-0.8	V
f_T	$V_{CE}=-5.0\text{V}$ $I_C=-0.5\text{A}$ $f=30\text{MHz}$		100		MHz
C_{ob}	$V_{CB}=-10\text{V}$ $I_E=0$ $f=1.0\text{MHz}$		50		pF

h_{FE} 分档、印章/ h_{FE} Classifications、Marking:

h_{FE} 分档/ h_{FE} Classifications	P	Q	R
h_{FE} 范围/ h_{FE} Range	82~180	120~270	180~390
印章/Marking	HBCP ※	HBCQ ※	HBCR ※

